

Politechnika Świętokrzyska  
Dział Zamówień Publicznych

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7  
25-314 Kielce  
tel. 41 34 24 140, 41 34 24 270

oznaczenie sprawy ATZ-381/24-7/19

**Zbiornicze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do nanoszenia powłok metodami PECVD i PVD; urządzenia do nanoszenia powłok atomowych metodą ALD dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej**

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

**część I**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 508 000,00 PLN brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty PLN	Okres udzielonej gwarancji (miesiące)	Termin realizacji zamówienia (dni)
1.	Technolutions Miłosz Czajkowski ul. Jana Pawła II 52/56 99-400 Łowicz	1 506 750,00	24	125

**część II**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 402 989,50 PLN brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty PLN	Okres udzielonej gwarancji (miesiące)	Termin realizacji zamówienia (dni)
1.	Technolutions Miłosz Czajkowski ul. Jana Pawła II 52/56 99-400 Łowicz	2 402 190,00	12	168
Dodatkowe parametry urządzenia				
a) komora próżniowa jest wyposażona w układ chłodzenia wodą wraz z chłodziarką b) komora reakcyjna jest wymienna i instalowana wewnątrz komory próżniowej bez specjalnych narzędzi c) linie źródeł ciekłych prekursorów (grzanych i niegrzanych) pozwalają na różne rodzaje modów przepływów: - mod normalny: wyjście zbiornika prekursora jest otwarte podczas trwania pulsów, - mod przepływu bezpośredniego: wlot/wylot ze zbiornika są otwarte i przepływ gazu nośnego zachodzi bezpośrednio poprzez zbiornik (bąbelkowanie) - mod napelnij/zwolnij: wlot zbiornika prekursora jest otwierany na moment i napelniany gazem nośnym, następnie ciśnienie jest zwalniane poprzez otwarcie zaworu wylotowego d) urządzenie ma możliwość utrzymania linii prekursorów w temperaturze wyższej niż temperatura źródła				

e) mod przepływu poprzecznego tj. przepływu poziomego – przepływ prekursora wewnątrz komory reakcyjnej równoległy do płaszczyzny podłogi – wejście prekursorów do komory reakcyjnej i wyjście prekursorów z komory reakcyjnej jest umieszczony na dwóch przeciwległych krańcach komory reakcyjnej w przekroju poprzecznym

f) system jest wyposażony w podwójny system zaworów pomiędzy zbiornikiem na prekursor a komorą reakcyjną dający możliwość odpompowania resztek prekursora przed podaniem kolejnego

g) urządzenie ma możliwość doposażenia systemu ALD o moduł plazmowy bazujący na plazmie wzbudzonej pojemnościowo CCP (Capacitively Coupled Plasma), z możliwością pracy plazmy bezpośredniej i oddalonej, gwarantujący możliwość procesów depozycji SiO<sub>2</sub> z czasem cykli krótszym niż 2 s

h) urządzenie ma możliwość rozbudowy systemu o minimum 2 źródła grzane do temperatury 500°C.